

※課題番号 : F-12-KT-0134
※支援課題名 (日本語) : 新規半導体薄膜形成のための原料開発
※Program Title (in English) : Materials development for new semiconductor film formation
※利用者名 (日本語) : 仁科 佐和子
※Username (in English) : Sanako Nishina
※所属名 (日本語) : 旭化成株式会社 先端技術研究所
※Affiliation (in English) : Asahi Kasei Corporation Central R&D Laboratories

※概要 (Summary) :

【相談内容】 新規半導体薄膜形成の為の原料開発において、原料の物性を確認する。また開発した材料にて膜製作のプロセス条件を検討する。

希望利用装置

- ・ダイナミック光散乱光度計
- ・ゼータ電位・粒径計測システム
- ・超高分解能電界放出型走査電子顕微鏡
- ・電子線蒸着装置
- ・スプレーコータ 等

【回答】 各種の装置群を利用していただいで希望するデータを得る事が可能。

【結果】 H24 年度自主事業として利用。

※実験 (Experimental) :

技術相談の為割愛

※結果と考察 (Results and Discussion) :

技術相談の為割愛

※その他・特記事項 (Others) :

なし